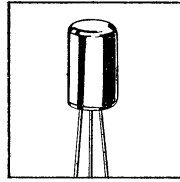


2SD186

ゲルマニウム・NPN・合金接合型
AF増幅用



☆AF 小信号増幅用です。

- ★Germanium NPN alloy transistor.
- ★For small signal AF amplifier.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	2SD186	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	25	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	12	V
コレクタ電流	I_C	150	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	85	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+85	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	min.	typ.	max.	単位
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			15	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$			12	μA
小信号電流増幅率	h_{fe}	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}, f=1\text{kHz}$		120		
遮断周波数	$f_{\alpha b}$	$V_{CB}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}$		1		MHz
雑音指数	NF	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}, f=1\text{kHz}$ $R_g=500\Omega, \text{帯域幅}=100\text{サイクル}$		7		dB
ベース拡がり抵抗	$r_{bb'}$	$V_{CE}=1.5\text{V}, I_C=30\text{mA}, f=6\text{MHz}$		120	220	Ω

※2SD186 は指定回路におけるコレクタ電流により次のように分類しています。

60mA 以上	A	17mA	B	68mA
---------	---	------	---	------

- これより P_C の大きいものは 2SD187⇨ p226
利得分類基準回路

